

1. Хлыбов А.И., Родионов Д.В., Егоркин В.И., Котляров Е.Ю., Лосев В.В., Чаплыгин Ю.А. Исследование зависимостей входных параметров нормально-закрытого GaN-HEMT-транзистора от режимов работы в гигагерцовом диапазоне // Известия высших учебных заведений. Электроника. 2024. Т. 29. № 6. С. 763-771.
2. Egorkin V.I., Chukanova O.B. Normally off GaN transistor for a complementary pair // Semiconductors. – 2024. Vol. 58, no 13. – P. 1132-1136
3. Егоркин В.И., Земляков В.Е., Неженцев А.В., Зайцев А.А., Гармаш В.И. Особенности температурной стабильности сопротивления омических контактов к наногетероструктурам на основе GaAs и GaN // Физика и техника полупроводников. – 2021. – Т. 55, № 12. – С. 1260-1263.
4. Egorkin V.I., Bepalov V.A., Zaitsev A.A., Zemlyakov V.E., Капаев V.V., Kukhtyaeva O.B. Normally-off p-gate transistor based on AlGaIn/GaN heterostructures // Semiconductors. – 2021. Vol. 55. – P. 1039-1044.
5. Savinov S.A., Mityagin Y.A., Danilov P.A., Kudryashov S.I., Ionin A.A., Kazakov I.P., Tsekhosh V.I., Khmel'nitsky R.A., Telenkov M.P., Nagaraja K.K., Egorkin V.I. Investigation of GaAsBi epitaxial layers for THz emitters pumped by long-wavelength fiber lasers // Optical Materials. – 2020. Vol. 101. P. 109716.
6. Егоркин В.И., Земляков В.Е., Капаев В.В., Кухтяева О.Б. Моделирование нормально закрытого HEMT транзистора на основе GaN/AlGaIn с р-затвором // Микроэлектроника. – 2020. – Т. 49. – № 6. – С. 474-480.